

D1F60**600V 1A****特長**

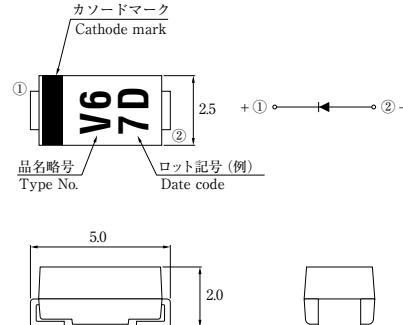
- 耐湿性に優れ高信頼性

Feature

- High-Reliability

■外観図 OUTLINE

Package : 1F

Unit : mm
Weight : 0.058g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

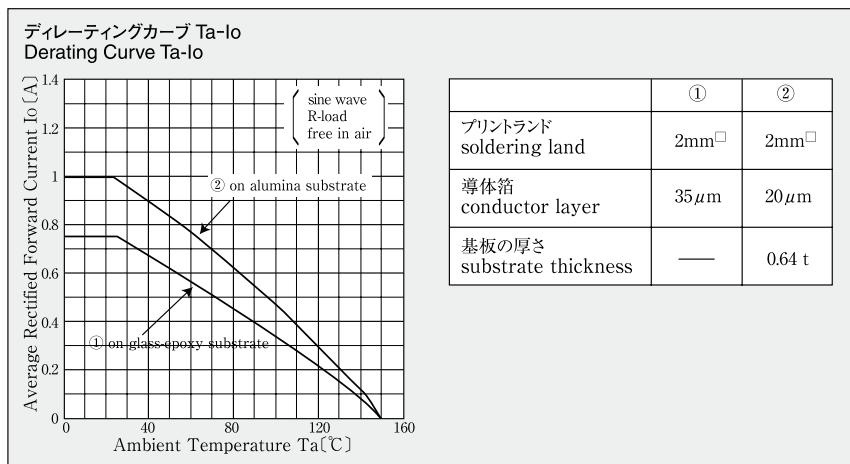
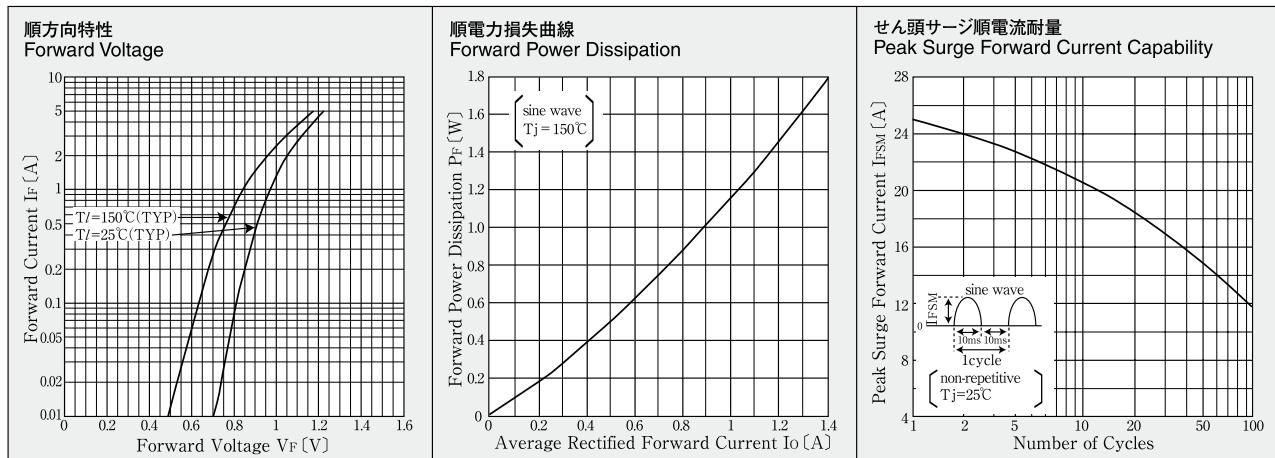
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $TJ=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1F60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_a=25^{\circ}\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a=25^{\circ}\text{C}$	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.0	A
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	0.75	
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j=25^{\circ}\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j=25^{\circ}\text{C}$		25	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $TJ=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=1A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θjl	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 23	°C/W
	θja	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 108 MAX 157	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
- * Typical is a statistical average of the device's ability.
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
- * Typical is a statistical average of the device's ability.